

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
für leistungssparende Video-Endstufen
in Fernsehempfängern

Bauform 6 TO126

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 20 \text{ K/W}$
 $R_{thja} \leq 104 \text{ K/W}$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

U_{CBO}	250 V
U_{CEO}	250 V
U_{EBO}	5 V
I_C	30 mA
I_{CM}	100 mA
P_{tot} ($\vartheta_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1,2 W
($\vartheta_c = 110 \text{ }^\circ\text{C}$)	2,0 W
ϑ_j	150 $^\circ\text{C}$
ϑ_a	-40 ... +125 $^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25 \text{ }^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

$U_{(BR) CBO}$	($I_C = 10 \text{ } \mu\text{A}$)	$\geq 250 \text{ V}$
$U_{(BR) CEO}$	($I_C = 2,5 \text{ mA}$)	$\geq 250 \text{ V}$
$U_{(BR) EBO}$	($I_E = 10 \text{ } \mu\text{A}$)	$\geq 5 \text{ V}$
I_{CBO}	($U_{CB} = 200 \text{ V}$)	$\leq 50 \text{ nA}$
h_{21E}	($U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 30 \text{ mA}$)	≥ 50

Dynamische Kennwerte

$-C_{12e}$	($U_{CB} = 30 \text{ V}, I_C = 0, f = 1 \text{ MHz}$)	$\leq 1,8 \text{ pF}$
C_{22e}	($U_{CB} = 30 \text{ V}, I_C = 0, f = 1 \text{ MHz}$)	$\leq 4,5 \text{ pF}$
$ h_{21b} $	($U_{CB} = 20 \text{ V}, -I_E = 10 \text{ mA}, f = 10,7 \text{ MHz}$)	
ω		$\leq 90 \text{ ps}$
T	($U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}, f = 20 \text{ MHz}$)	$\geq 60 \text{ MHz}$